PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

59-045912

(43) Date of publication of application: 15.03.1984

(51)Int.Cl.

C01B 21/068

// B01J 8/28

(21)Application number: 57-151741

(71)Applicant: KAWASAKI STEEL CORP

KAWASAKI REFRACT CO LTD

SHOWA DENKO KK

(22) Date of filing:

02.09.1982

(72)Inventor: MAEDA EIZO

SHINTANI HIROTAKA

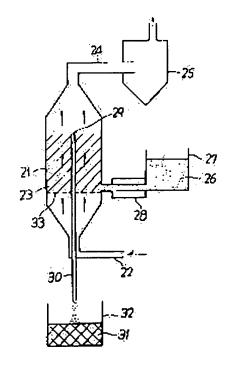
EMI TOSHIHIKO

(54) CONTINUOUS PREPARATION OF SIALON SUBSTANCE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare sialong substance in a mass at a low cost, by charging a mixture of carbon and silica or silica.alumina compound continuously from the top of the reactor, and fluidizing and reacting with the N2containing gas stream supplied from the bottom of the reactor.

CONSTITUTION: Powdery or granular mixture 26 of carbon and silica or a silica.alumina compound is supplied from the container 27 through the feeder 28 to the top reaction chamber of a fluidizing apparatus 21, and is fluidized with the N2-containing gas supplied from the inlet 22 attached at the bottom of the reactor. The fluidized mixture is made to react with the N2-containing gas, and the produced silicon nitride or the sialon



substance is discharged continuously through the outlet 30 to the container 32. The exhaust gas of the reaction is discharged through the gas outlet 24 and the dust collector 25 from the system.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-45912

⑤ Int. Cl.³C 01 B 21/068// B 01 J 8/28

識別記号

庁内整理番号 7508-4G 7202-4G ④公開 昭和59年(1984)3月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

ぬサイアロン系物質の連続製造法

願 昭57-151741

②出 願 昭57(1982)9月2日

⑩発 明 者 前田栄造

@特

千葉市川崎町1番地川崎製鉄株

式会社技術研究所内

仰発 明 者 新谷宏隆

千葉市川崎町1番地川崎製鉄株

式会社技術研究所内

加発 明 者 江見俊彦

千葉市川崎町1番地川崎製鉄株 式会社技術研究所内

⑪出 願 人 川崎製鉄株式会社

神戸市中央区北本町通1丁目1

番28号

⑪出 願 人 川崎炉材株式会社

赤穂市中広字東沖1576番地の2

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9

号

⑭代 理 人 弁理士 杉村暁秀 外1名

明 細 習

1. 発明の名称 サイアロン系物質の連続製造法 2. 特許韶求の範囲

- 2 投入原料混合物を予め遊位し、設造粒された粒子を窒素含有ガスによつて流動化させる

ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のサイアロン系物質の連続製造法。

a. 発明の詳細な説明

本発明はサイアロン系物質の連続製造方法に関し、特に多量のサイアロンや窓化駐緊を安価に供給し得る製造法の提案を目的とする。

窒化建業を比較的安価に製造する方法として、 シリカとカーボンの混合物を選紧合有雰囲気中で 熱処理することにより選化建業を得る方法が知ら れている。また、同様にシリカ・アルミナ系化合物とカーボンとの混合物を選集含有雰囲気中で熱処理することによりサイアロンが得られることも別られている。窒化進業およびサイアロンの合成反応を式で示すと以下のようになる。.

$$3 SiO_2 + 6 O + 2 N_2 - Si_3 N_4 + 6 OO$$
 ... (1)
 $PA \ell_2 O_8 \cdot q SiO_2 + r O + s N_2$

(ただし、p,a,r,s,tは係数)

こういつた方法で窒化珪素あるいはサイアロンを合成しようとするとき、一般には原料のシリカあるいはシリカ・アルミナ系化合物とカーボンの粉末とをあらかじめ混合造粒して直径数mmのペレントとし、反応室内に装入する方法がとられている。

連続的製造法には大きく分けて2種類の方法が知られている。一つは第1図に示すような、台板7上に前述のペレット1を乗せ、反応室4内に装入し、窒素含有ガス3と反応させ製品2を得る方法である。反応室4は気密に保たれ、間欠的に気

解消し、効率よく窓化建業あるいはサイアロンを合成する連続製造法を提供するものであつて、その骨子はカーポンとシリカあるいはシリカ・アルミナ系化合物を主体とした混合物を、施動層形成設置の上方より連続的に装入し、下方から吹き込まれる窓紧含有カス流で流動化し、窒化建業あるいはサイアロン系物質を合成する連続製造法である。

本発明者らは、前記従来方法について検討を重ねた結果、器化建業あるいはサイフののはシリカ・が気相・脳相反応であり、シリカあるいは当れた合物中の酸素が気が中の設立と、経済をであることがあることがあるのでは、かっては、かっては、かっては、かっては、かっては、ないで、ないのでは、ないで、ないのでは、ないで、ないのでは、ないで、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないいのでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないでは、

密ドア 8 を開け、ブッシャー 9 で台板 7 を押し、 台板1の出し入れを行なう。台板はガイド10上 をスライドして、第1凶においてはたから右へ流 れる。この場合、ペレットを厚く切み重ねると下 方のペレットへの窒素の供給が充分に行なわれず、 逆に耐み重ねが少なければ生産はが上がらないた め、生産性は低い。もう一つは第2図に示すよう に竪型の反応器の上方の装入口11から前述のペ レットを連続的に投入し、反応室4内で営業含有 ガス3と反応させ、反応後のペレット2を下方の 切出し装置12から取り出す方法である。この場 合、ペレットは自催でお下するため、ペレット径 が小さくなると下方への流れが恐くなり、ときに はブリッジングをおこし全く流れなくなることが ある。そのためペレット径は一定以下には小さく できない。また。ペレット径が大さいとペレット の中心まで反応させるのに長時間かかり、そのた めこの方法の生産性は前者より高いが、十分に高 いものとはいえなくなる。

本発明は、このような従来の製造方法の欠点を

浮遊しており、粒と粒との投触時間は短かい。しかし合成反応が気相 - 歯相反応であるため、流動 脳現象により選化反応を進めることが可能になる ことを見出した。

以下に、本発明方法の構成を具体的な実施態様に基づいて、図面を参照して幹細に説明する。

び3 図は本発明の方法を実施するための流動層 装置の1例を示すもので、シリカもしくはシリカ・ アルミナ系化合物およびカーポンと云つた原料粒 子2 Hはフィーダー2 8 を通して流動層 2 1 へ迎 緑的に送り込まれる。反応ガスでありしかも流動 化ガスでもある累累含有ガスは、ガス導入口2 2 から成動層内に送り入れられる。反応後の排ガス は排川口2 + から系外へ排出される。合成された 選化建業あるいはサイブロンは、排出管30を通 じて放動層外の容器32へ連続的に排出される。

粒子をガスで鋭動化させるための条件は一般によく知られている。ガス焼蛍が少なければ脱動化しないし、ガス脱壁が多すぎると粒子は脱動層から跳れ出してしまう。また、ガス焼蛍が一定ならば、粒径が大きすぎると鋭動化はおこらず、逆に粒径が小さすぎると粒子は脱される。したがつて、

遊校した粒径が大きすぎると、反応が粒の中心 部まで選するのに時間がかかり、かえつて生産性 が小くなる。また、避粒することにより工程がひ とつ均えることになる。そのため、製産条件にあ わせ、遊紋するか、あるいは原料粉末をそのまま 単独で沈幼崎内に装入するか、を決めれば良い。

施動層反応には多くの利点があるが、それには 装入原料の粒度、ガス量、反応時間等の諸条件と 密接な関係があり、さらにこれらの条件は、原料 から製品への転化、しかも均等な低化に僅めて重 要である。

成動層内での粒子の複拌は良好であつて、原料の粒子を放動層内に装入するとすぐに均一に分散される。そのため、原料を脱動層内へ連続的に供給し、連続的に合成物を取り出そうとするとき、 装人された原料の一部は未反応のまますぐに強動 別から取り出されることがある。 就動層から取り 出される粒子のうち、反応のおこつているものの 別合を反応転化率というが、反応転化率は上記の 即山により、一部米反応の原料あるいは反応の 原料粉末であるシリカあるいはシリカ・アルミナ 系化合物およびカーボンは、所定の粒度に調整されたものを用いる必要がある。

反応により CO ガスが生成されるために、反応が進むにつれてカーボン粒子は製面から消耗し、しだいに粒径が小さくなる。粒径が小さくなると、流動化条件を満足しきれなくなり、粒子はガスに流されて系外へ流出する。そのため、反応を継続させるためにカーボンを過剰に加える必要がある。カーボンを過剰に加えても反応には思い影響をおよぼさない。

反応は気相 - 固相反応であるため、シリカあるいはシリカ・アルミナ系化合物の設面から反応がおこる。そのため、シリカあるいはシリカ・アルミナ系化合物の粒径の小さい方が反応時間は短かくなる。

粒径が小さすぎると焼動化条件を満たすガス放 進が小さくなり、生遊鼠を上げることはできない。 しかし、原料をあらかじめ遊粒し、適当な大きさ をもつた粒子にすることで、ガス流はを多くする ことができ、生産鼠を上げることができる。

充分な原料も泥没するので1にはなり難い。

の粒子排出口29′から次の鉱動層へ粒子は装入される。さらに反応が進んだところで次の統動層へ数入される。3段以上の流動層ではこれがくりかえされる。最下段の流動層からは製品排出口29から系外へ連続的に排出される。流動化ガスである密素含有ガスはガスは粒子とは反対方向に動き、ガス排出質24から系外へ排 される。

一つの設での反応率をαとすると、n 背目の流動 値での転化率 an は、

an
$$-1 - (1 - \alpha)^n$$
 (3)

で与えられる。例えば一般の反応半は - 0.8 の場合でも3 段近ねると転化率は 0.992 ~ 1.0 となる。したがつて、流動層を2 段または 8 段以上近ねることで効率的に転化半を上げることが可能となる。なお相み重ねの段数は3~4 段が最も効果的である。

また、多段炎の流動層を使用することで、原料からの脱水工程を省くことが可能となる。 すなわち、前述のようにここで述べている窒化珪楽ある

以下実施例について詳細に説明する。

先す一段協動財による実施例およびこれと同じ 内径の従来の整型反応装置による比較例について 級別する。

災廠例1.

シリカ敵として粒径80~50mの建砂を、

いはサイアロンの合成反応は気相 - 適相反応であ り、顔紫分丘に影響される。気相中の観紫分氏が 高くなると反応は遅くなり、酸紫分圧がある低よ り大きくなると反応は進行しなくなる。例えば、 原料中に水分が含まれていると斑動層内に水蒸気 が持ち込まれ、それによつて酸素分圧が高くなり、 反応が進まなくなる。そのため、一般式の流動が ではあらかじめ原料を脱水し、それを窒化珪素の 原料と1. て用いなければならない。1. か1. 名段式 の流動層では流動化ガスは吸上段をすぎると排出。 されるだけであり、最上段に水分が持ち込まれて も、反応全体におよほす水蒸気の影響は大きくな いので、最上段を脱水のための装置とすることが できる。こうすることにより、原料からの脱水工 程を省くことが可能となる。原料中に含まれる水 分としては、吸着水、原料造粒時のパインダーに 含まれる水分、および粘土鉱物の構造水のように 結晶中に含まれる水分などがある。

多段式の流動層中に装入する原料粒子の粒径は 流動化条件を満足する瞬間で自由に遮訳できる。

夹施例 2.

シリカ・アルミナ系化合物として粘土(810g 6 2 % , Al2O8 2 3 % , H2O 1 2 %)と、カーボン顔としてコークス粉(炭素含有益 0 0 %)とを、原料としてサイアロンを合成した。粒径 4 4 Fa 以下の粘土と、粒径 4 4 Fa 以下の コークス粉とを、コークス/粘土ー 0.4 の割合となるように配合し、混合体をボールミルで混合・粉砕したのち粒径 0.15 ~ 0.8 mm となるように心粒した。 心粒

した粒子を800℃で燃成して脱水を行ない、球料粒として用いた。

比較例

実施例2と同様の原料を1~2 m および5~7m に 溶粒し、同様に脱水を行なつた。

内径 8 5 maの 竪型の 反応器の上方からペレットを投入し、反応後、 反応器の下部からペレットを取り出すという 従来方法により、 サイアロンを合成した。 反応管内には N₂ ガスを 8 0 Ne / 時の流はで上方に向って流した。 反応管内の温度は 1 4 0 0 C に 保持した。

1~2 mmの粒径に造粒したペレットを用いた場合、反応開始後の時間でブリッジングをおこし、

版料としてサイアロンを合成した。粒径44μm 以下の粘土と、粒径44μm以下のコークス粉とをコークス/粘土-リ.4の割合となるように混合し、混合体をポールミルで混合、粉砕したのち、粒径 0.15~ 0.3 mm となるように遊粒した。

上述のように避粒した粒を、8段式の流動層に

別入しサイアロンを合成した。流動層の内径は

85 mであり、そこへ流動化ガスとして360

Nt / 時の流出で N2 ガスを流した。流動層内の温度を1400 Cに保ちながら、理統的に順料を装入し、連続的に製品を取り出した。上記条件でサイアロンの製造を行なつたところ、低化率99 %のサイアロンを4009/時で得ることができた。比較例1.

災施例と同様に粒径 0.15~0.8 m に避粒した粒を川い、1段式の成動層でサイアロンを合成した。 造粒した粒を 8 0 0℃で焼成して脱水を行なつたのち、成動層内に数人した。

焼動型の内径は 8 5 mm であり、そこへ 成動化ガスとして 3 5 0 N4 / 時の硫酸で Ng ガスを成した。

合成されたペレットを反応録の下方から取り出すことができなくなつた。また、5~7 mmの校底に造むしたペレットを原料として用いた場合には、鉱化率9 0 ものサイアロンを + 0 9 / 時の生産はでしか得ることができなかった。

以上のように「段税動局を用いることで、シリカあるいはシリカ・アルミナ系化合物から窒化珪素またはサイアロンを得るのに、従来方法に比較して生産性の著しい向上がみられ、効率よく合成することが可能となつた。

しかし、転化率は従来法に比較して傾かながら 良くなつているが、尚92%の転化率であつて、 製品品質の一層の向上が設まれるので、多段式流動
が設置を使用した実験と、比較例として1段流動
が設置と従来の竪型反応装置による実験を行なった。

寒 尬 例

シリカ・アルミナ茶化合物として粘土 (SiO₂ 6 2 5 , Al₂O₈ 2 3 5 , H₂O 1 2 5)と、カーポン酸としてコークス粉 (炭素含有は 0 0 5)とを

就動層内の温度を1400℃に保ちながら、連続的に原料を装入し、連続的に製品を取り出した。 上記条件でサイアロンの製造を行なつたところ、 低化率 82 あのサイアロンを 4009/時でしか 得ることができなかつた。

反応管内には N₂ ガスを 8 0 N ℓ / 時の 旅 は で 上 方に向って 讹 した。 反応管内の 温度は 1 4 0 u ℃ に 保持した。

1~2 mの粒径に遊粒したペレットを用いた場合、反応開始後 6 時間で粒のブリッジングをおこし、合成されたペレットを反応質の下方から取り出すことができなくなつた。また、 5 ~ 7 mmの粒径に 遊粒したペレットを原料として用いた場合には、 伝化半9 0 5 のサイアロンを 4 10 9 / 時の生産出てしか得ることができなかつた。

以上のように、多段式の磁動超級選を用いることで、シリカあるいはシリカ・アルミナ系化合物から品質の優れた窒化珪素あるいはサイアロンを効率よく合成することが可能となつた。

なお、本発明は上記実施例に限らず、本発明の

持開昭59-45912(8)

の要官の範囲内であれば、すべてに適用できるこ とは云うまでもない。

上述のように、本発明は従来法に比較して、良 智の選化註案あるいはサイアロンを、生産性よく 従って安価に多位に供給できる製造方法であって 当該技術分野の要型に応え、業界に貢献するとこ ろ値めて大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は従来の製造法の説明図、 第8凶は実施例であつて1段式流動層の場合、

第4図は他の実施例の3段式流動層の場合の各

説明図である。

1…原料ペレット

2 … 製品ペレット

a… 選業含有ガス

4 … 反応室

6 … 川然炉

6 … 排気口

7 … 台版

8 … 気密ドア

9 ... ブツシャー

10…ガイド

1 1 … 装入口

12… 切出し装置

1 8 … 製品容器

2 1 … 说 動 慰

22…旅動化ガス海入管

2 3 … 流動坡 2 4 … ガス排出管 2 5 … 集的機 2 8 … 原科粉水虫たは粒

2 7 … 原料容器

28 ... 71 - 4 -

2 9 … 製品排出口

29'…次の流動層への粒子排出口

3 0 … 製品排出質

3 0 / … 次の流動層への排出装入質

8 1 … 製品

8 2 … 製品容器

3 3 … 仕切り板

特許出願人 川崎蜘鉄株式会社

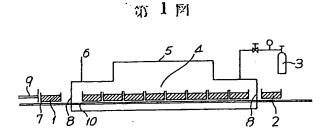
同 出願人 川畅炉材株式会社

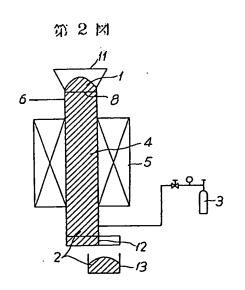
問 出願人 图和电工株式会社

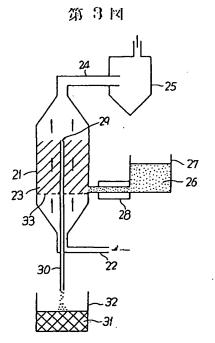
代迎人弁理士

升埋士

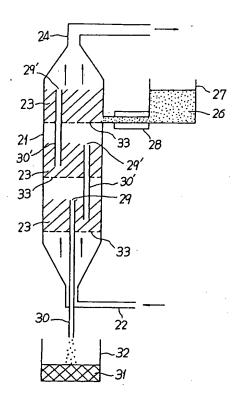








第 4 因



(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—223299

Int. Cl. ³		^{強別記号}	庁内整理番号	3 公開	昭和59年(1984)12月15日				
C 30 B 2	29/62		7417—4G						
C 01 B 3	31/02		7344—4G	発明♂					
C 30 B 2	25/00		7417—4G	審査請	す求	未請求			
2	29/02		7417—4G						
D 01 F	9/12		7199—4 L				(全	4	頁)

函熱分解による気相法炭素繊維の製造法及び装

置

②特 願 昭58-92332

②出 願 昭58(1983)5月27日

70発 明 者 森本信吾

大町市大町6953-4

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9

号

個代 理 人 弁理士 青木朗

外3名

明 細 「

1. 発明の名称

熱分解による気相法炭素機維の製造法 及び装隆

2. 特許請求の範囲

- 1. 気相法による炭素繊維の製造法において、 炭素繊維生成帯域にて炉内空間に多数のセラミッ ク片を充てんし、且つこれらのセラミック物体間 の空間にて炭化水素の熱分解が起こるよう、該炭 化水素および前記セラミック体を加熱することを 特徴とする炭素繊維の製造法。
- 2 様型炉本体と、この炉内を加熱する加熱手段を含んでなり、炉の上部入口側にセラミック片送入手段及び炭化水素ガス送入手段が設けられ、炉の下部出口側にガス排出手段およびセラミック片排出手段が設けられていることを特徴とする装置
- 3. 発明の詳細な説明
- (イ) 発明の技術分野

本発明は炭化水素の熱分解による気成法炭素

機維の製造法及び装置に関する。

炭素機維は有機機維の炭化により製造される他、 気相法によっても製造でき、後者の複雑は結晶発 遠が低めて少ない為にその特徴を生かした用途が 期待できる。しかも気相法による繊維は14m前後 と非常に細い為に電気伝導性を持ちつつ比表面が 大きいことを要求される用途も期待できる。

(中) 背景技術

気相法による炭素複維の製造方法では、Fe. Co. Ni 等の微粉末が炭素複維の生成に寄与することが実験により確認されており、特に、直径設百Å以下のいわゆる超像粒が炭素複雑の収量に対して傾めて大きな効果を与えることも解明された。

付 従来技術と問題点

従来の気相法による炭素機能の製造法は炭素 酸能の生成帯域に10 A以下の優粒又は超微粒子 状の耐熱性金属あるいは金属化合物を存在させ、 所定温度に加熱された電気炉内に原料ガスを流し、 その熱分解を行う方法である。

例えば、特開昭 5 1 - 3 3 2 1 0 号公報は Sic

発熱体(シリコニット)を傭えた炉内にアルミナ 質炉芯管(内径60㎜、艮さ1000㎜)を水平 にセットし、炉芯管内には基板として黒鉛製の円 筒スリープ(外径60㎜、艮さ300㎜、肉厚5 ㎜)を装入し、また炉芯管の両端はガス導入等な よび排出管付の蓋で密封したうえで、初め炉芯管 内を水素ガスで罹後し、次いでスリープ内の温度 を約1060℃に保ち、ペンセンと水素の混合ガ スを流すことによって、スリープに炭素徴雑を成 長させている。

また、特開船57-117622号および
57-117623号公報は300Å以下の超微粉末のみを炭素機維生成帯域に存在させることにより、生産性を高めることを開示している。これらの従来の気相法炭素機能の製造法では、直径10~20μ、長さ5~10cmの機維を得るのに4~5 Hr 要していた。よって従来の気相法による炭素機能の製造法に、他の機維製造法に比較して、その生産性は依然として低いという欠点がある。

従来法において、基板面積を広くすると、提時

臼 発明の目的

本発明の目的は、気相法炭素繊維を高効率、 すなわち時間当り高収量で製造することを目的と する。

/ 発明の構成

本発明者は、従来法における炭素繊維生成中の挙動を検討したところ、生成の初期の炭階では 頂径1 μ前後で長さ1~2 cmの極く細い線維が恭板上に成長し、その機維が生成のそれ以降の段階では成長と主として直径の増加をすることを確認した。そこで、上記初期の段階で熱分解反応を停止すれば、他の機維製造法では得られない細い機維が得られることになる。しかし単に熱分解反応時間を短縮しただけでは、1 炉および1 回分当りの機権収得重量が優端に低いので、炉内空間の利用率を向上させる方法を見出した。

本発明に係る方法は、気相法による炭素機能の

製造法において、炭素機維生成帯域にて炉内空間 に多数のセラミック片を充てんし、且つこれらの セラミック物体間の空間にて炭化水素の熱分解が 起こるよう、ស炭化水素および前記セラミック体 を加熱することを特徴とする。

この方法の構成を以下説明する。

加熱温度は一般的には950~1300℃の範囲で選ばれる。この範囲で、メタン等低分子の炭化水素の場合は高目の温度、脂肪族高分子及び芳香族炭化水素ではやや低目の温度が好ましい。炭化水素はペンゼン、トルエン、メタン、エタン等多くの炭化水素が使用できる。この炭化水素ガスをキャリアガスと共に硫し、所定の温度に上げる。本発明では炉芯管として通常のコランダム質、石英質等のものを使用した炉を用いた。

キャリアガスには H₂ ガスが用いられるが、これ にアルゴン、窒素ガス等の不活性ガスを 1 部混合 してもよい。混合の場合は H₂ ガスが 5 0 容 代 多 以 上とすることが好ましい。このキャリアガスを炉 の上方から下方へ流して炭化水素ガス(ペンセン など)が所定磁度で流れるのが好ましく、逆にキャリアガスを下から上方へ流すと、炭化水素ガス (ペンセンなど)は水素キャリアガスとの比重差 のために炉の下部にて濃度が様維生成に不向きに なる。

m. 艮さ5~10mが好ましい。これらのセラミック片は所定炉内空間に動力下で充てんされる。

上記方法は模型炉を用いてパッチ式での異施が可能である。しかしながら後述の速焼方式がより好ましい。パッチ式の場合はセラミック片を先ず加熱し、これが炭化水素の熱分解弧度に違した時に、炭化水素を炉内に導入するのがよい。

連続方式の場合は、縦型炉又はキルン型回転炉を用い、セラミック片が炉内に装入され、炉内を 重力により又はキルンの回転により通過せしめられ、炭素機維がその上に付流した状態で炉から取り出され、そして炭素機維分離後、契面に付源した熱分解炭素を除去してから再度シーディングされるして炉内に装入される。さらに、セラミック片の炉内への装入および取り出し方向は、とするには上から下向へであるが、下から上向へとすることも可能である。

本発明に係る装修は、連続運転が可能であると ともに気相法炭素徴維生成の特徴を生かしたもの であって、縦型炉本体とこの炉内を加熱する加熱

は用いずに Celle などを炉内に送入する質よりな る。炭化水素送入手段は、炉内に開口し、更にカ ーポンプラックの生成を避けるために、図示のよ 5 化反応符2a 化遊している。4 は管よりなるセ ラミック片の送入手段であり、炉内の滴当な位置 に末端が位置する。5は炉壁に取り付けられた管 よりたるガス排出手段であり、畝鯛の質を用いる 必要がある。 6 は、炉の飛下部に取り付けられた 管よりなり、シャッター(図示せず)などによっ て、セラミック片の排出角を調節し炉内でのセラ ミック片10の下降速度を制御できるように構成 されたセラミック片排出手段である。尚、セラミ ック片排出手段 6 にガス吸引用ポンプを取り付け るとガス及びセラミックの排出は共通の手段で行 われる。セラミック片10の移動速度は、約1100 での反応帯 2 b を 1 ~ 1.5 Hr で通過するような値。 が適当である。

更に、炉の下部にHz などのガスを冷却荷 2c に送り、セラミック片 1 0を冷却するガス送入口 7が設けられている。炉の上部にHz などのキャリ

手段を含んでなり、炉の上部入口側にセラミック 片送入手段及び炭化水素ガス送入手段が設けられ、 炉の下部出口側にガス排出手段およびセラミック 片排出手段が設けられていることを特徴とする。

上記接限においては、様型炉内にセラミック片の下降移動方向で予熱帯、反応帯および冷却帯を 形成するように加熱手段にて加熱することが好ま しい。

更に、上記芸能において800 で以下の炉内下熱帯又は冷却帯で Ce He 等を含むガスにセラミック片が触れるとカーボンブラックのみが生成し繊維とならないので、予熱帯及び冷却帯部には Ce He ガスが混入しないで、反応帯にのみ添加することが炭素微維の収率を高めるうえで好ましい。 以下、本発明の装置の実施腹様を図面により説

図面において、1は疑型炉本体、2は予熱帯2a、反応帯2b、冷却帯2cに分けられる加熱手段、例えばヒーターである。3は、炭化水系送入手段であり、H2などのキャリヤーガスを用い又

アガスを炉内に導入するガス送入口 8 が散けられてもよい。

以下、本発明の実施例を説明する。

(4) 奥施例

明する。

(1) 効果

比較的に細くて短かい炭素複雑を連続的にか つ効率良く得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

- 図而は本発明に係る装置の概念図である。

1 … 縱型炉本体. 2

2 …加熱手段。

3 … 炭化水素送入手段.

4 …セラミック片の送入手段。

5 … ガス排出手段、 6 … 管 、

7…ガス送入口。

特 許 出 類 人 昭 和 電 工 株 式 会 社

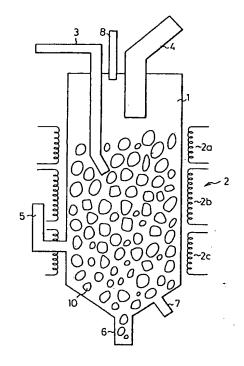
特許出願代理人

 弁理士
 育
 木
 別

 弁理士
 酉
 縮
 和
 之

 弁理士
 村
 井
 卓
 准

 弁理士
 山
 口
 昭
 之



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-48708 (P2003-48708A)

(43)公開日 平成15年2月21日(2003.2.21)

(51) Int.Cl.7 C 0 1 B 31/02 酸別配号 101

FΙ C 0 1 B 31/02

ァーマコート (参考) 101Z 4G046

審査請求 未請求 請求項の数1 〇L (全 6 頁)

(21)出廢番号

特顏2001-238555(P2001-238555)

(22) 出願日

平成13年8月7日(2001.8.7)

(71)出願人 000001993

株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

(72)発明者 吉瀬 良文

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会

社島津製作所内

(74)代理人 100098671

弁理士 喜多 俊文 (外1名)

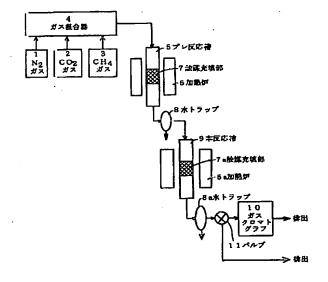
Fターム(参考) 40046 CA01 CC02 CC08

(54) 【発明の名称】 炭素製造装置

(57)【要約】

【課題】 鉄を主成分とする触媒を用いて低温で炭素を 析出することができる炭素製造装置を提供する。

【解決手段】 二酸化炭素とメタン及びその他の炭素源 を含む混合ガスを、触媒30wt%Ni/SiO2が充 填されたプレ反応槽5に流す。加熱炉6によって550 ℃の反応温度で、二酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭 素の混合ガスに変換し、その後、鉄を主成分とする触媒 50wt%Fe/SiO₂が充填された本反応槽9に流 し、加熱炉6aによって400℃の低温にて二酸化炭素 を水素と接触還元反応をさせて表面に炭素を析出させ る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】二酸化炭素とメタンおよびその他の炭素源を含む混合ガスを供給ガス源として二酸化炭素を固定化し炭素を製造する炭素製造装置において、前記混合ガスを二酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭素の混合ガスに変換するプレ反応槽と、その変換された混合ガスを、鉄を主成分とする金属触媒が用いられ、低温にて水素と二酸化炭素を接触還元反応させて表面に炭素を析出させる本反応槽とを備えたことを特徴とする炭素製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、二酸化炭素、メタン及びその他、炭素源を含む混合ガスから炭素を製造する装置に係わり、特に、金属触媒を用いて二酸化炭素を固定化し、触媒の表面に炭素を析出し製造する炭素製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】大気中の温室効果ガス濃度を低減するた めに、いろいろな方法が研究されている。大気中の二酸 化炭素(CO₂)や、発電所、製鉄所、セメント工場な どから大量に排出されるCOっを排出源で固定して再資 源化する方法の一つに、例えば、水素(H2)雰囲気下 でCO2を還元し、微粉状炭素に変換する方法が考案さ れている。その変換方式は、大気や排ガスからCO2を 分離するCO。分離装置や、その分離されたCO。を濃 縮するCOっ濃縮装置、COっとHっ(又はCH4)を 触媒存在下で反応させて微粉状炭素を生成するCO2/ H₂(又はCH₄)反応装置などから構成されている。 このCO2/H2(又はCH4)反応装置(以下、二酸 化炭素固定化装置という)は、例えば、SiO2やA1 2 O3 を担体とするNi、Coなどの触媒を備え、H2 (又はCH₄が触媒反応により炭素と水素に分解しその 水素)と固定化するCOっとを取り込み、触媒存在下で 反応させて連続的に水素と水を生成する。その反応式 は、CO₂ + 2H₂ → C + 2H₂ O - 96. 0kJ/m o 1である。二酸化炭素と水素の反応式から判るように 二酸化炭素1mo1当たり96.0kJの熱量を発生す る。また、二酸化炭素固定化装置で生成した水蒸気(H 2 O) を凝縮する凝縮部が設けられ、その凝縮部を通す ことによって、生成した水を排出する。

【0003】図3に、従来の二酸化炭素固定化によって 炭素を製造する炭素製造装置の構成を示す。固定化する 二酸化炭素とメタン(又は水素)ガスが、所定の混合比 にされてガス供給口21から供給ガスとして装置内に供 給される。コンプレッサ22は、供給ガスの圧力を高め 熱交換器23に導入する。熱交換器23は、反応槽25 の排気管28からの高温の排気ガスの予熱を吸収して、 コンプレッサ22からの供給ガスを暖める。ここで熱交 換された供給ガスは、ガス導入口24から反応槽25に 導入される。図4に、CO₂と、CH₄を分解してでき

るH₂を触媒存在下で反応させて微粉状炭素を生成する 反応槽25を示す。反応槽25は、内部に触媒27を入 れた反応器25aが設けられ、この反応器25aは、下 部からの供給ガスが触媒27の間を上部に通りぬけるこ とができ、触媒27が外部の加熱炉34の遠赤外線ヒー タ36によって500~600℃程度に加熱される。触 媒27としてSiO2やAl2O3を担体とするNi、 Coなどの触媒が用いられる。加熱された触媒27に供 給ガスが触れ、メタンガスは触媒反応により炭素と水素 に分解する。そして二酸化炭素はその水素と反応して、 炭素と水(水蒸気)になる。炭素は、触媒表面に着床し 固定化炭素35となる。反応時に発生した温度の高い余 剰の水素、水蒸気、未反応の二酸化炭素、メタンが反応 槽25から排出される。そのガスは熱交換器23を通 り、熱交換され凝縮器29に入り冷却されて、水蒸気は 凝縮し、水となって外部に排出される。残りの未反応の ガスは冷却されて元のガス供給管に戻り、再び外部から の二酸化炭素・メタン(又は水素)の供給ガスと混合さ れて、コンプレッサ22で圧縮される。そして固定化装 置を再び循環する。

【0004】所定時間、反応ガスを循環させたのち、固 定化装置の電源を止めて、定期的に固定化した炭素を触 媒27と共に反応槽25から取り出す作業を行う。反応 槽25の下部に設けられた触媒/炭素排出口30を開放 にして、反応器25aの下部に設けられた触媒流動槽保 持機構26をレリーズする。反応器25aの内部に固定 化され触媒27上に付着した固定化炭素35が、触媒2 7と共に下方に降下し、触媒/炭素排出口30から排出 される。排出された固定化炭素35と触媒27は触媒炭 素分離器31に貯められる。この両者を機械的に振動さ せて触媒27上に付着した炭素を剥離し、サイクロンで 触媒27と炭素を分離して、炭素のみを外部に取りだ す。炭素が分離された触媒は、触媒再生器32に導入さ れ、活性剤を入れて新しい触媒に再生される。再生され た触媒27は再び、反応槽25の上部に設けられた触媒 供給口33から反応槽25の内部の反応器25aに導入 される。この作業を繰り返し、二酸化炭素から炭素を固 定化し、炭素が分離され製造される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来の炭素製造装置は以上のように構成されており、 SiO_2 や Al_2O_3 を担体とする粉末、球状等のNi、Coなどの触媒27が用いられるが、Ni、Coなどの触媒27は高価なものであるため、最近、安価な鉄を主成分とする触媒を用いる方法が考案されている。しかし、鉄を主成分とする触媒は、反応温度が700 C以上の高温が必要であるという問題がある。

【0006】本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、鉄を主成分とする触媒を用いて低温で 炭素を析出することができる炭素製造装置を提供するこ とを目的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、本発明の炭素製造装置は、二酸化炭素とメタンおよびその他の炭素源を含む混合ガスを供給ガス源として二酸化炭素を固定化し炭素を製造する炭素製造装置において、前記混合ガスを二酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭素の混合ガスをご酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭素の混合ガスを、鉄を主成分とする金属触媒が用いられ、低温にて水素と二酸化炭素を接触還元反応させて表面に炭素を析出させる本反応槽とを備えたものである。

【0008】本発明の炭素製造装置は上記のように構成されており、供給ガスの反応系に直列にプレ反応槽と本反応槽を設け、プレ反応槽で、まず二酸化炭素とメタンの混合ガスを二酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭素の混合ガスに変換し、その後、本反応槽で、鉄を主成分とする金属触媒を用いて、低温にて二酸化炭素を水素と接触還元反応をさせ表面に炭素を析出させている。そのため、NiおよびCoなどの触媒に比べて安価なFeを主成分とする触媒を用いて、Ni、Co並みの低温にて炭素析出反応を行うことができる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明の炭素製造装置の一実施例を、図1を参照しながら説明する。図1は本発明の炭素製造装置の炭素生成能を測定した概略構成図を示す。本炭素製造装置は、触媒30wt%Ni/SiO2が充填された触媒充填部7とその触媒充填部7を550℃に加熱できる加熱炉6とを備え、反応ガスが二酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭素の混合ガスに変換されるプレ反応槽5と、プレ反応槽5で生成した水を除去する水トラップ8と、変換された混合ガスを、鉄を主成分とする触媒50wt%Fe/SiO2が充填された触媒充填部7aとその触媒充填部7aを400℃に加熱できる加熱炉6aとを備え、二酸化炭素が水素と接触還元反応して触媒表面に炭素を析出する本反応槽9と、本反応槽9で生成する水を除去する水トラップ8aとから構成されている。

【0010】本炭素製造装置は、プレ反応槽5と本反応槽9とを直列に接続配置し、反応ガスを、プレ反応槽5と鉄を主成分とする触媒を用いた本反応槽9の2ステップによって、550~400℃の低温で反応させるものである。以下に、内部標準ガスとしてのN2ガス1、反応ガスとしてのCO2ガス2及びCH4ガス3と、これらの各ガスを所定の混合比に混合するガス混合器4と、ガス組成比を分析するためのガスクロマトグラフ10を用いて、本発明の炭素製造装置の炭素生成能を測定する場合の各部の機能と反応過程を、図1に示す構成図に沿って順次説明する。

【0011】内部標準ガスとしてのN₂ガス1は、反応 ガスに混合して反応流路に流され、出力側のガスクロマ トグラフ10による分析時に、反応ガスの組成比の標準ガスとして用いられ、10%の混合比で流される。ガス混合器4は、 N_2 ガス1、 CO_2 ガス2、 CH_4 ガス3が混合され、 CO_2 ガス2と CH_4 ガス3が混合される。そして総流量は、断面を20mm径に換算すると、200m1/min程度に設定される。

【0012】プレ反応槽5は、触媒充填部7と加熱炉6から構成され、触媒充填部7は、触媒30wt%Ni/Si O_2 が充填され、加熱炉6は、触媒充填部7を550℃に加熱できるものである。そして、反応ガスのCH $_4$ ガスが触媒により、最初にCH $_4$ =C+2H $_2$ +9<math>0. 1kj/molの吸熱反応をし、水素を発生する。そして、二酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭素の混合ガスに変換される。

【0013】触媒充填部7の触媒は、30wt%Ni/SiO₂が用いられる。その調製方法は、硝酸ニッケルNi(NO₃)₂・6H₂O、140gを、イオン交換水約500ccに溶解した水溶液に、SiO₂担体(AEROSIL380)70gを入れ、十分に混練を行ったものを、100 $\mathbb C$ 、3hr乾燥させた後、電気炉にて、300 $\mathbb C$ 、4hr焼成を行って調製される。

【0014】水トラップ8は、反応ガスが $CH_4+CO_2=2C+2H_2O-5$. 9kj/molの反応を行い、少量の熱を加えるだけで炭素と水を生成するので、その蒸気を冷却して凝縮し、ドレインの凝縮した水を外部に排出する。

【0015】本反応槽9は、触媒充填部7aと加熱炉6aから構成され、触媒充填部7aは鉄を主成分とする触媒50wt%Fe/SiO₂が充填され、加熱炉6aは、触媒充填部7aを400℃に加熱できるものである。プレ反応槽5で変換された混合ガスは、400℃に加熱された触媒50wt%Fe/SiO₂により、二酸化炭素が水素と接触還元反応して、 $CO_2 + 2H_2 = C + 2H_2 O - 96kj/molが行われ、反応が一定に進行している時、全体の反応は、<math>CH_4 + CO_2 = 2C + 2H_2 O - 5.9kj/molとなり、少量の熱を外部から加えるだけで、触媒表面に炭素を析出する。$

【0016】触媒充填部7aの触媒は、50wt%Fe $/SiO_2$ が用いられる。その調製方法は、プレ反応槽 5用の触媒の調製方法において、硝酸ニッケル $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2$ Oの代りに、硝酸鉄 $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2$ O348gを、イオン交換水約500ccに溶解した水溶液に、 SiO_2 担体(AEROSIL380)50g を入れ、十分に混練を行ったものを、100 $\mathbb C$ 、3h r 乾燥させた後、電気炉にて、300 $\mathbb C$ 、4h r 焼成を行って調製される。

【0017】水トラップ8aは、反応ガスが $CH_4+CO_2=2C+2H_2O-5$. 9kj/molの反応を行い、少量の熱を加えるだけで炭素と水を生成するので、

その蒸気を冷却して凝縮し、ドレインの凝縮した水を外部に排出する。

【0018】ガスクロマトグラフ10は、反応後のガスを、バルブ11を介して導き、そのガス組成比を分析するものである。基準となる標準ガスは N_2 ガス1が用いられ、反応ガス(CO_2 ガス2、 CH_4 ガス3)と一緒に10%混合比で混合されて反応流路に流される。本反応槽9からの反応後のガスは、反応しなかった余剰の CO_2 ガス2、 CH_4 ガス3や、 H_2 ガス、CO ガス、水蒸気と標準ガスの N_2 ガス1である。ガスクロマトグラフ10は N_2 ガス1を基準として、これらのガス組成比を分析する。本装置は、分析データにより各ガスの混合割合、混合ガスの流量、プレ反応槽5及び本反応槽9の反応温度等を制御し、最適に触媒表面に炭素を析出することができる。

【0019】実施例の反応後ガス組成比(%)について、図2にそのグラフを示す。図2は、内径20mmの石英管に上記触媒をそれぞれ充填し、プレ反応槽5と本反応槽9を直列に接続して固定床にし、図1に示すような流通式反応により、CO2ガス2とCH4ガス3を供給し、プレ反応槽5を定温反応にて30分間反応させた後、本反応槽9を昇温させ、定温反応を行った本反応槽9でのデータ例を示す。縦軸が反応後ガス組成比

(%)、横軸は反応時間 (min)を示す。反応条件は、触媒量がプレ反応槽5では0.05g、本反応槽9では0.5g、反応温度がプレ反応槽5では550℃、本反応槽9では400℃、CO₂ガス2とCH₄ガス3の比は7:3、総流量は200m1/minである。

【0020】図から判るように、プレ反応槽5を定温反 応にて30分間反応させた後、本反応槽9を昇温させ、 定温反応を行っているので、まず、反応ガスのCH4ガ スが触媒により、最初にCH₄ = C+2H₂+90.1 k j/m o l の吸熱反応をし、C H₄ が減少して、H₂ を発生している。そして、スタート時にはメタン、二酸 化炭素、一酸化炭素であった混合ガスが、メタン、水 素、二酸化炭素、一酸化炭素の混合ガスに変換されてい ることが判る。同時に炭素も生成し始めている。そして 本反応槽9の温度が400℃に定温度になると、全体の 反応は、 $CH_4 + CO_2 = 2C + 2H_2 O - 5.9kj$ /molとなり、少量の熱を外部から加えるだけで、触 媒表面に炭素を析出し、メタン、水素、二酸化炭素、少 量の一酸化炭素の排出ガスとなることが判る。そして、 温度を下げることによりスタート時のメタン、二酸化炭 素、一酸化炭素の混合ガスに戻る。そして、本実施例で 得られた炭素/触媒比は5/1であった。

[0021]

【発明の効果】本発明の炭素製造装置は上記のように構成されており、二酸化炭素とメタンが混合された供給ガ

スを、プレ反応槽と本反応槽が直列に配置された反応流路に流し、触媒30wt%Ni/SiO $_2$ が充填されたプレ反応槽で、550 $^{\circ}$ Cの反応温度で二酸化炭素、メタン、水素、一酸化炭素の混合ガスに変換し、その後、鉄を主成分とする触媒50wt%Fe/SiO $_2$ が充填された本反応槽に流し、400 $^{\circ}$ Cの低温にて二酸化炭素を水素と接触還元反応をさせて表面に炭素を析出させる。そのため、Ni およびCo などの触媒に比べて安価なFeを主成分とする触媒を用いて、Ni、Co 並みの低温にて炭素を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の炭素製造装置の一実施例を示す図で ある。

【図2】 本発明の炭素製造装置の反応温度400℃における反応時間に対する反応後ガス組成比を示す図である。

【図3】 従来の炭素製造装置の構成を示す図である。 【図4】 従来の炭素製造装置の反応槽を示す図である。

【符号の説明】

1…Nっガス

2…CO2 ガス

3…CH4 ガス

4…ガス混合器

5…プレ反応槽

6、6 a…加熱炉

7、7 a…触媒充填部

8、8a…水トラップ

9…本反応槽

10…ガスクロマトグラフ

11…バルブ

21…ガス供給口

22…コンプレッサ

23…熱交換器

24…ガス導入口

25…反応槽

25 a…反応器

26…触媒流動槽保持機構

27…触媒

28…排気管

29…凝縮器

30…触媒/炭素排出口

31…触媒炭素分離器

32…触媒再生器

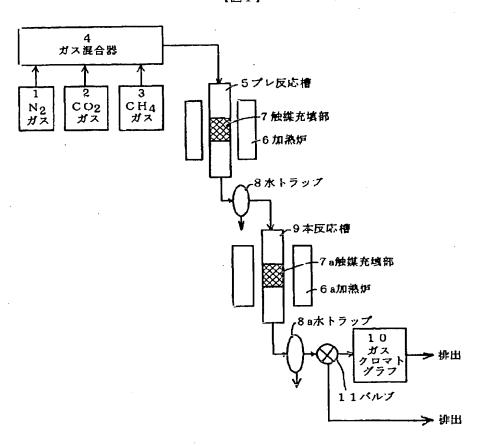
33…触媒供給口

34…加熱炉

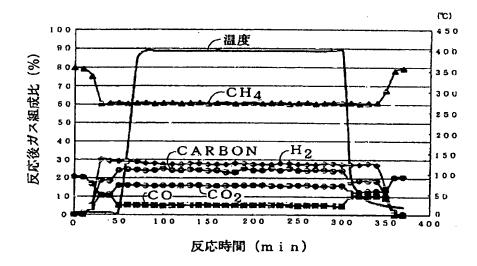
35…固定化炭素

36…遠赤外線ヒータ

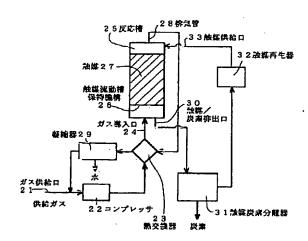
【図1】



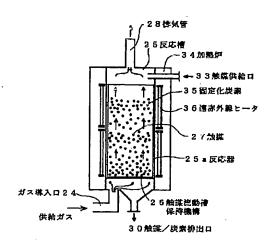
【図2】



【図3】



【図4】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.